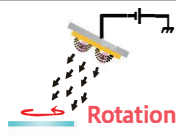
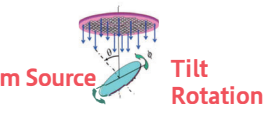
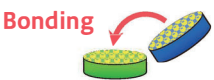


先端半導体を支える薄膜形成加工技術

幅広いプロセスご要求に応える製品群

テクノロジー	適用例	詳細	装置
極薄膜の積層	ロジック 不揮発性メモリ イメージセンサー	原子レベル膜厚制御性と 優れた均一性を実現する スパッタ	 FC7100 NC7900 NC7940
高スループット	ロジック DRAM	独自のマグネット制御 機構搭載 平行平板スパッタ	IC7500
高被覆性	パワーデバイス 実装	高周波 (60 MHz) イオン化スパッタ	
難エッチング材 特殊形状加工	不揮発性メモリ 実装	広角チルトホルダ搭載 イオンビームエッチング	 NC8000
常温ウエハー 接合	接合プロセス全般	原子拡散接合法による 無加熱・無加圧接合	 BC7300

NC7900

φ200 / φ300 mm



特長

最大32材料の積層を
超高真空環境で一貫
成膜が可能

NC8000

φ200 / φ300 mm



特長

イオンビームエッチン
グ、後酸化処理、パッシ
ベーション成膜の連
続処理が可能

IC7500

φ300 mm



特長

配線工程に最適な高
い生産性と安定性を
備えたスパッタ装置

IC1060

φ150 / φ200 mm



特長

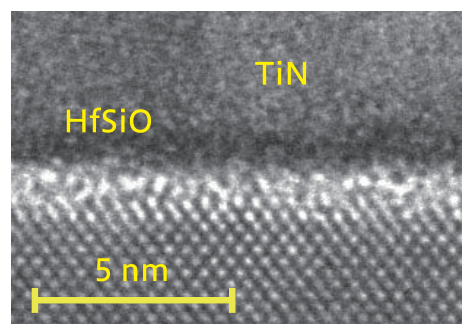
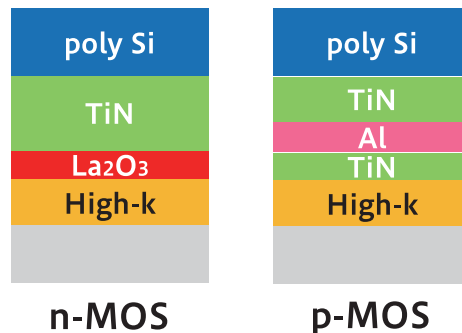
パワーデバイスや化合
物半導体等の小口径
基板に特化した標準
的なスパッタ装置

原子層レベルの極薄膜成膜

FC7100

ø 300 mm

High-K Metal Gateトランジスタ
DRAM周辺トランジスタに適用

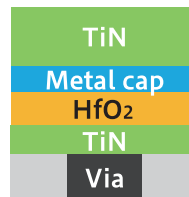
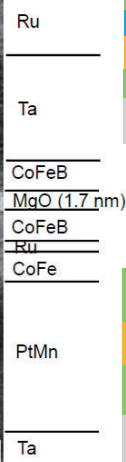
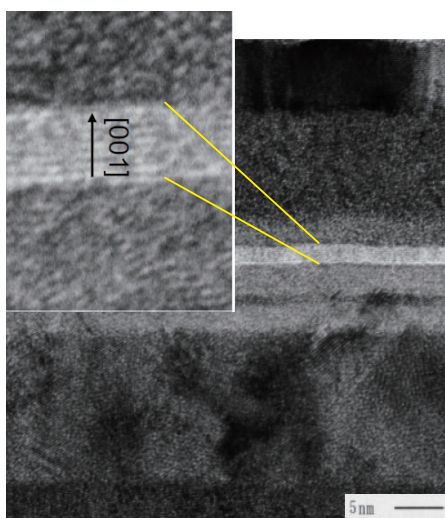


TEM image of HKMG

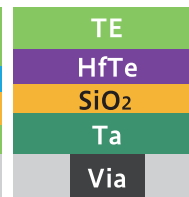
NC7900 / NC7940

ø 200mm / ø 300mm

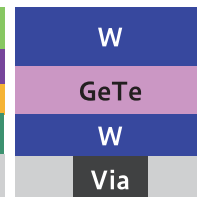
MRAMの極薄多層膜量産実績で培った極薄膜制御技術は
次世代不揮発性メモリ等の実現に貢献



OxRAM



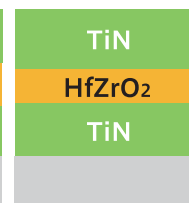
CBRAM



セレクトラ



FeRAM



MIM



ジョセフソン接合

MRAM

TEM image of MgO

さまざまな次世代デバイスに対応しております。是非、説明員にお声がけ下さい!

3Dデバイスを実現する常温接合

BC7300 / BC7000

W2W接合向け原子拡散接合装置

無加熱・無加圧のウエハー接合を実現します

BC7300 $\phi 200 / \phi 300$ mm

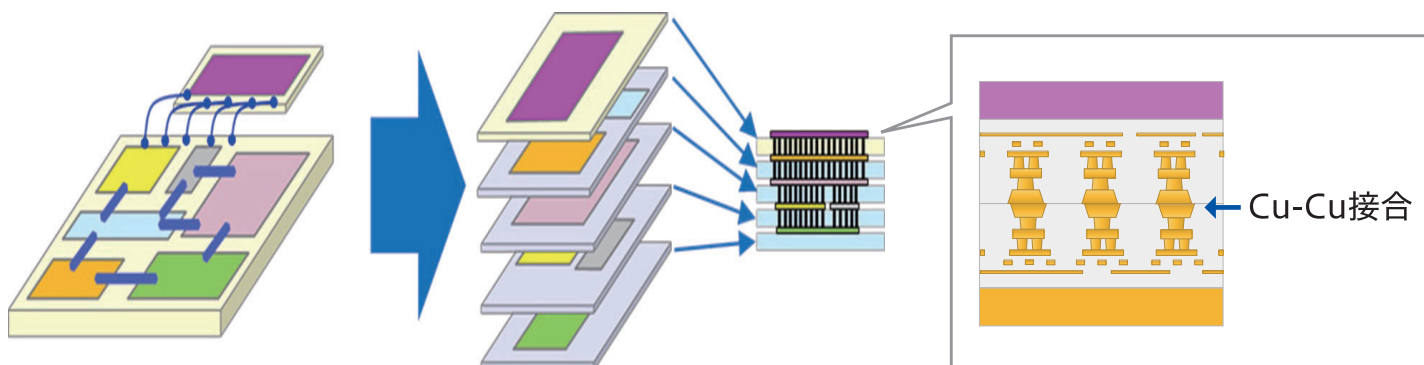


BC7000 $\phi 100 / \phi 150$ mm

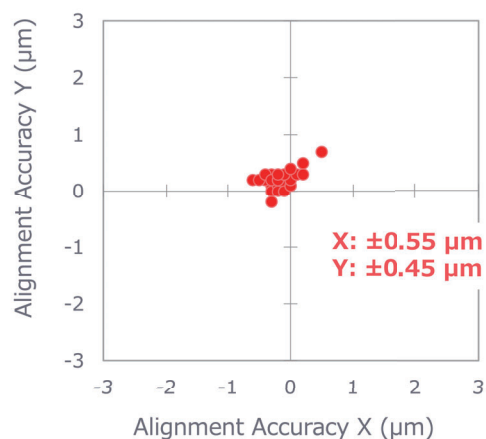


ヘテロジニアスインテグレーション

シリコンと化合物、光学素子などの異種材料接合



BC7300アライメント精度



※本データ値は高精度ユニット/低振動床 (VC-F相当) 環境で取得 保証値ではありません

高機能基板向け接合

SiC、GaN、InP、ダイヤモンド、
LT、LNなどの高機能接合基板

